

# 中华人民共和国国家标准

GB 11072—89

---

## 铋化锑多晶、单晶及切割片

**Indium antimonide polycrystal, single  
crystals and as-cut slices**

1989-03-31发布

1990-02-01实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 铋化锑多晶、单晶及切割片

GB 11072—89

Indium antimonide polycrystal, single  
crystals and as-cut slices

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铋化锑多晶、单晶及单晶切割片的产品分类、技术要求和试验方法等。

本标准适用于区熔法制备的铋化锑多晶及直拉法制备的供制作红外探测器和磁敏元件等用的铋化锑单晶及其切割片。

### 2 引用标准

GB 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB 8759 化合物半导体单晶晶向 X 射线衍射测量方法

### 3 产品分类

#### 3.1 导电类型、规格

##### 3.1.1 多晶

多晶的导电类型为 N 型,按载流子迁移率分为三级。

##### 3.1.2 单晶

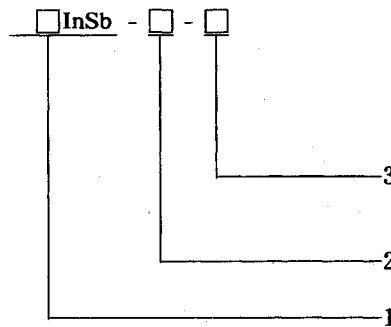
铋化锑单晶按导电类型分为 N 型和 P 型,以掺杂剂、载流子浓度和迁移率分类,按直径与位错密度分为三级。

##### 3.1.3 切割片

按 3.1.2 分类与分级,其厚度不小于 500  $\mu\text{m}$ 。

#### 3.2 牌号

##### 3.2.1 铋化锑多晶与单晶的牌号表示为:



1——用 PInSb 表示铋化锑多晶, MInSb 表示铋化锑单晶;